

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成17年3月10日(2005.3.10)

【公表番号】特表2001-507723(P2001-507723A)

【公表日】平成13年6月12日(2001.6.12)

【出願番号】特願平9-532961

【国際特許分類第7版】

C 0 8 F 8/46

C 1 0 M 143/00

C 1 0 M 145/00

// C 1 0 N 30:04

【F I】

C 0 8 F 8/46

C 1 0 M 143/00

C 1 0 M 145/00

C 1 0 N 30:04

【手続補正書】

【提出日】平成16年7月7日(2004.7.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書



16.7.-7
平成 年 月 日

特許庁長官 小川 洋 殿

1. 事件の表示 平成9年特許願第532961号

2. 補正をする者

事件との関係 出願人

名称 エクソン ケミカル パテンツ インコーポレイテッド

3. 代理人

住所 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
電話(代) 3211-8741

氏名 (5995) 弁理士 中村 稔



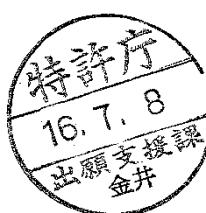
4. 補正命令の日付 自発

5. 補正により増加する請求項の数 1

6. 補正対象書類名 明細書

7. 補正対象項目名 明細書及び請求の範囲

8. 補正の内容



1. 請求の範囲を別紙の通り訂正する。
2. 明細書10頁、下から11～10行の
「C₃～C₁₀モノ不飽和ジカルボン酸」を
「C₃～C₁₀モノ不飽和モノカルボン酸」と補正する。

請求の範囲

1. モノ不飽和C₃からC₁₀のモノカルボン酸を生成する化合物及びモノ不飽和C₄からC₁₀のジカルボン酸を生成する化合物から成る群から選択されるカルボン酸を生成する化合物のポリアルケニル誘導体を製造する低タール、低沈殿物の方法であって、該方法が前記カルボン酸を生成する化合物を数平均分子量が約300から500であるポリアルケンと、沈殿物一阻害量の油溶性ヒドロカルビル置換スルホン酸の存在下、少なくとも約200°Cの反応温度、少なくとも約200kPaの不活性気体の分圧下、かつ、前記カルボン酸を生成する化合物のポリアルケンに対するモル比を約0.9:1から3:1で反応させる工程を含む方法。
2. ポリアルケン及び油溶性ヒドロカルビル置換スルホン酸の混合物を反応温度で供給し、次いで混合物を反応温度に保持しつつカルボン酸を生成する化合物を添加する工程をさらに含む、請求項1に記載の方法。
3. 不活性気体の分圧が約200から1000kPaの範囲にある、請求項1又は2に記載の方法。
4. 反応温度が約200から300°Cである、請求項1ないし3のいずれか1に記載の方法。
5. ポリアルケンが約30%より多くない末端ビニリデンポリマー鎖を、好ましくは約15%より多くない末端ビニリデンポリマー鎖を有する、請求項1ないし4のいずれか1に記載の方法。
6. ヒドロカルビル置換スルホン酸が、ポリアルケン及びカルボン酸を生成する化合物の全重量に基づいて、約0.05から1.0wt.%の量で存在する、請求項1ないし5のいずれか1に記載の方法。
7. ヒドロカルビル置換スルホン酸が分子当たり約24から40の炭素原子を含むア

ルカリールスルホン酸である、請求項1ないし6のいずれか1に記載の方法。

8. アルカリールスルホン酸が約475から600の範囲の数平均分子量を有するアルキル化ベンゼンスルホン酸を含む、請求項7に記載の方法。

9. モノ不飽和C₄からC₁₀のジカルボン酸を生成する化合物がモノ不飽和C₄からC₁₀のジカルボン酸並びにそれから誘導されるエステル及び無水物である、請求項1に記載の方法。

10. モノ不飽和ジカルボン酸を生成する化合物が無水マレイン酸を含む、請求項9に記載の方法。

11. モノ不飽和C₃からC₁₀のモノカルボン酸を生成する化合物がモノ不飽和C₃からC₁₀のモノカルボン酸及びそれから誘導されるエステルである、請求項1に記載の方法。